









	<p><b>SPI80N06S2-07</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SPI80N06S2-07</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 55V 80A I2PAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  SPI80N06S2-07.pdf</p> <p><b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 2500 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SPI80N06S2-07
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 55V 80A I2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2500 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 180µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO262-3-1
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.6 mOhm @ 68A, 10V
Verlustleistung (max)	250W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I <sup>2</sup> Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4540pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	110nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	55V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)

SPI80N06S2-07 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SPI80N06S2-07-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SPI80N06S2-07 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ SPI80N06S2-07 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SPI80N06S2L-05</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A I2PAK</p>	 <p><b>SPI80N08S2-07</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 75V 80A I2PAK</p>	 <p><b>SPI80N04S2-04</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 80A I2PAK</p>	 <p><b>SPI80N08S2-07R</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 75V 80A I2PAK</p>
 <p><b>SPI80N06S-08</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A I2PAK</p>	 <p><b>SPI80N03S2L-04</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 80A I2PAK</p>	 <p><b>SPI80N03S2L-05</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 80A I2PAK</p>	 <p><b>SPI80N06S2-08</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A I2PAK</p>

### SPI80N06S2-07 Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

SPI80N06S2-07 International Rectifier (Infineon Technologies)	SPI80N06S2-07 Datenblatt	SPI80N06S2-07-Datenblätter	SPI80N06S2-07 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) SPI80N06S2-07
SPI80N06S2-07 Electronic	SPI80N06S2-07-Komponenten	SPI80N06S2-07-Verteiler	SPI80N06S2-07-Bild	SPI80N06S2-07-Teil
SPI80N06S2-07 Preis	SPI80N06S2-07 Hersteller	SPI80N06S2-07 Bild	SPI80N06S2-07 Aktie	SPI80N06S2-07 Inventar
SPI80N06S2-07 Neu	SPI80N06S2-07 Original	SPI80N06S2-07 garantiert	SPI80N06S2-07 RFQ	SPI80N06S2-07 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited